

2SB676

シリコンPNPエヒタキシャル形トランジスタ
(PCT方式)(ダーリントン接続)

通信工業用

単位: mm

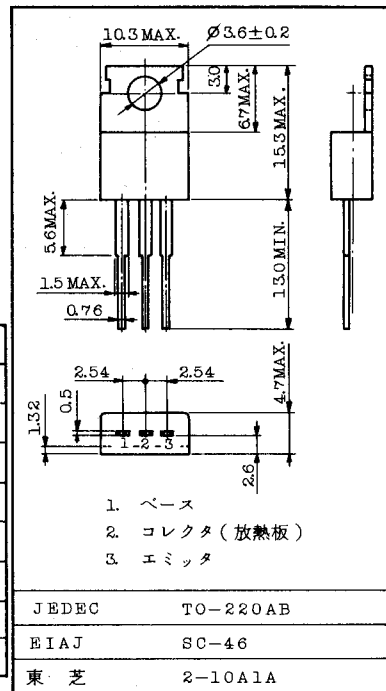
- スイッチング用
- ハンマードライブ, パルスモータードライブ用
- 電力増幅用

特 長

- ・ 直流電流増幅率が高い。
: $h_{FE} = 2000$ (最大) ($V_{CE} = -2V$, $I_C = -1A$)
- ・ 飽和電圧が低い。: $V_{CE(sat)} = -1.5V$ (最大) ($I_C = -3A$)
- ・ 2SD686 とコンプリメンタリになります。

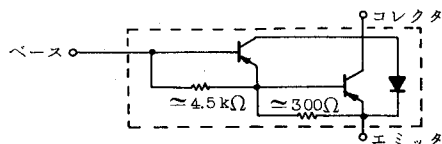
最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-4	A
ベース電流	I_B	-0.3	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	30	W
接 合 温 度	T_j	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



アクセサリは AC75 を適用

等価回路



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V$, $I_E = 0$	—	—	-20	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V$, $I_C = 0$	—	—	-2.5	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA$, $I_B = 0$	-80	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -2V$, $I_C = -1A$	2000	—	—	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V$, $I_C = -3A$	1000	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A$, $I_B = -6mA$	—	—	-1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -3A$, $I_B = -6mA$	—	—	-2.0	V
スイッチング 時 間	ターンオン時間	t_{on}	—	0.15	—	μs
	蓄 積 時 間	t_{stg}	—	0.80	—	
	下 降 時 間	t_f	—	0.40	—	

